

11.09.2025 – 10:01 Uhr

DB HiTek beginnt mit der Kundenunterstützung für den 650-V-GaN-HEMT-Prozess

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

- Schlüsseltechnologie treibt hohe Effizienz und Miniaturisierung für KI-Rechenzentren, Robotik und andere Anwendungen voran- Spezielles GaN-MPW-Set für Ende Oktober geplant - Erweiterung der BCD-Expertise auf Verbindungshalbleiter wie GaN und SiC

DB HiTek, ein führender Hersteller von 8-Zoll-Spezialchips, gab heute bekannt, dass sich die Entwicklung seines 650-V-E-Mode-GaN-HEMT-Prozesses (Galliumnitrid-Transistor mit hoher Elektronenbeweglichkeit), einer Leistungshalbleiterplattform der nächsten Generation, in der Endphase befindet. Das Unternehmen wird Ende Oktober auch ein spezielles GaN-MPW- (Multi-Project Wafer) Programm anbieten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Leistungsbauelementen auf Siliziumbasis bieten Halbleiter auf GaN-Basis eine überlegene Leistung unter Hochspannungs-, Hochfrequenz- und Hochtemperatur-Betriebsbedingungen und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Energieeffizienz aus. Insbesondere der 650-V-E-Mode-GaN-HEMT zeichnet sich durch seine hohe Schaltgeschwindigkeit und robuste Betriebsstabilität aus und eignet sich daher besonders für EV-Ladeinfrastrukturen, Stromumwandlungssysteme in Hyperscale-Rechenzentren und fortschrittliche 5G-Netzwerkgeräte.

2022, als der Markt für Verbindungshalbleiter noch in den Kinderschuhen steckte, identifizierte DB HiTek GaN und SiC als wichtige Wachstumstreiber und hat seitdem erheblich in die Prozessentwicklung investiert. Ein Sprecher von DB HiTek erklärte: „DB HiTek ist weltweit bereits für seine Führungsrolle bei siliziumbasierten Leistungshalbleitertechnologien bekannt, darunter die Entwicklung des branchenweit ersten 0,18-µm-BCDMOS-Prozesses. Durch die Erweiterung um GaN-Prozessfähigkeiten erwarten wir eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens mit einem breiten Technologieportfolio.“

Nach Fertigstellung des 650-V-GaN-HEMT-Prozesses plant DB HiTek bis Ende 2026 die Einführung eines 200-V-GaN-Prozesses und eines für die IC-Integration (Integrated Circuit) optimierten 650-V-GaN-Prozesses. Mit Blick auf die Zukunft strebt das Unternehmen an, seine GaN-Plattform entsprechend den Marktbedürfnissen und Kundenanforderungen auf ein breiteres Spannungsspektrum auszuweiten.

Um diese Initiativen zu unterstützen, erweitert DB HiTek die Reinraumanlagen von Fab2 in Chungcheongbuk-do, Südkorea. Die Erweiterung soll die Kapazität um etwa 35.000 8-Zoll-Wafer pro Monat erhöhen und die Produktion von GaN-, BCDMOS- und SiC-Prozessen unterstützen. Nach Fertigstellung wird die monatliche Gesamtkapazität von DB HiTek um 23 % von 154.000 auf 190.000 Wafer steigen.

Gleichzeitig wird DB HiTek an der ICSCRM (The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials) 2025 teilnehmen, die vom 15. bis 18. September im BEXCO in Busan stattfindet. Auf diesem globalen Branchenforum wird DB HiTek neben seinen GaN- und BCDMOS-Technologien auch die Fortschritte in der SiC-Prozessentwicklung vorstellen und direkt mit Kunden und Branchenführern in Kontakt treten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656225/image_5026888_21003402_Logo.jpg

View original content: <https://www.prnewswire.com/news-releases/db-hitek-beginnt-mit-der-kundenunterstuetzung-fur-den-650-v-gan-hemt-prozess-302551369.html>

Pressekontakt:

Hyunjoo Yu/ hyunjoo.yu1@dbhitek.com